Дисциплина "Основы электроники" **Лабораторная работа №7**

Полевой транзистор

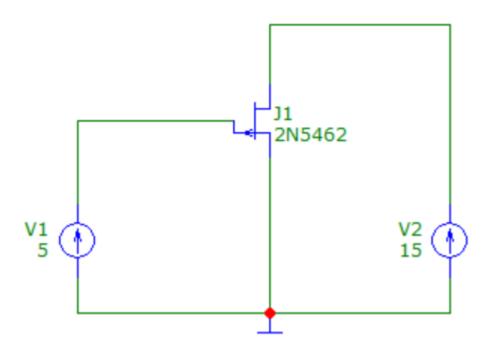
Работу выполнила: Ляпина Н.В. группа ИУ7-32Б вариант №12

Работу проверил:

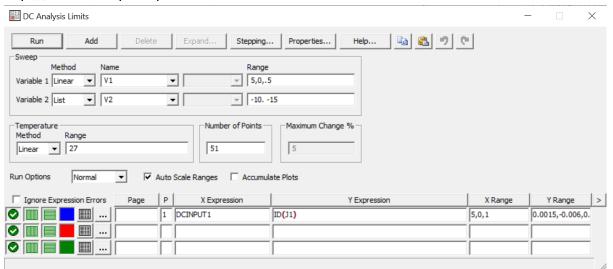
Цель работы: Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

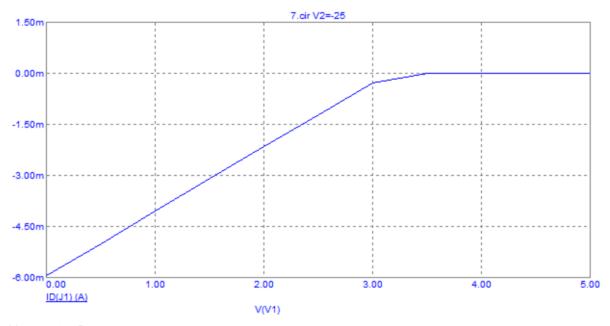
Эксперимент 7

рЈҒЕТ транзистор - 2N5462



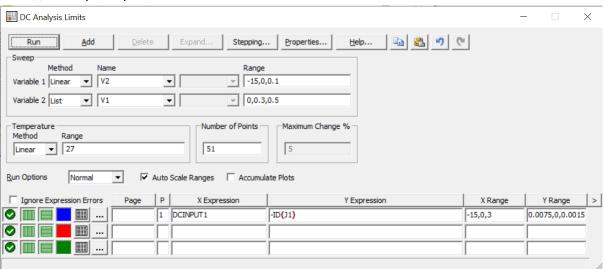
Передаточная характеристика:

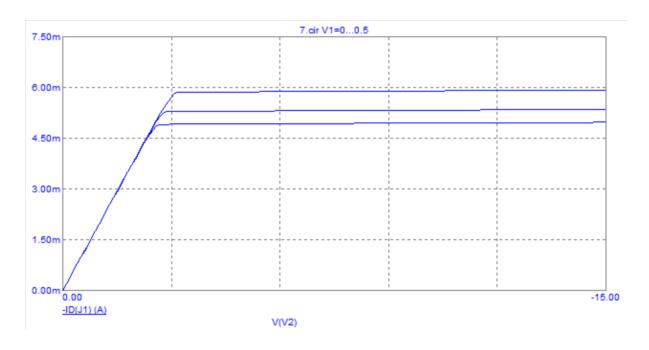




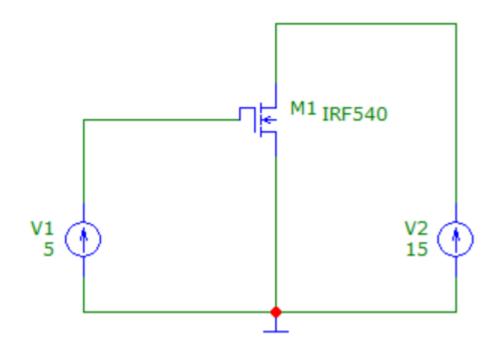
Uoтc = 3,5B Істока = 6мА Smax = 2 * Істока / Uoтc = 3.4 мA/B

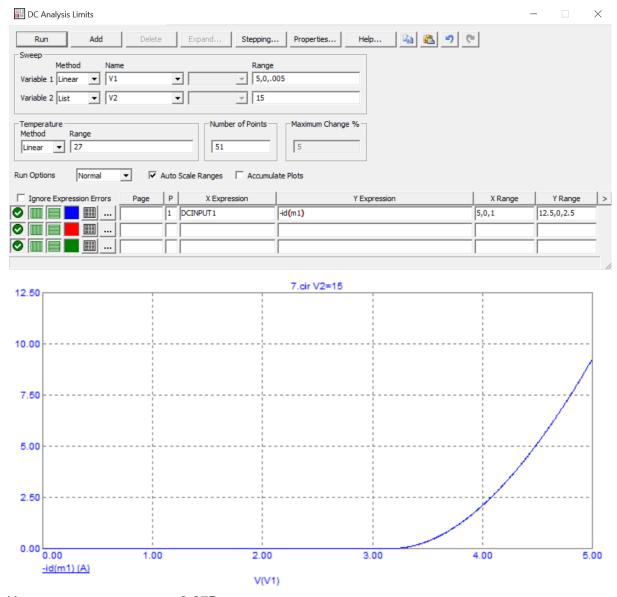
Выходная характеристика:





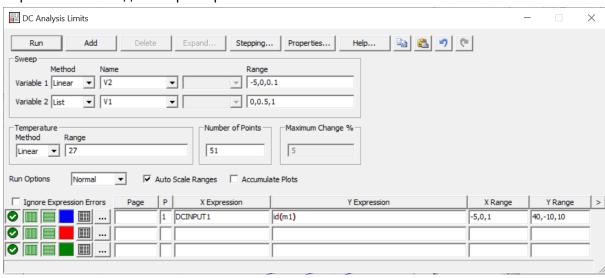
Заменим pJFET транзистор на nMOS и построим для него переходную и выходную характеристику nMOS - IRF540

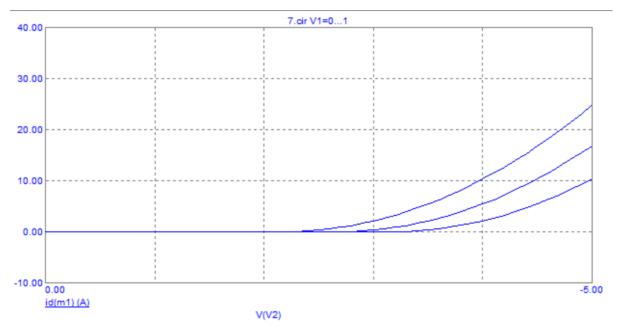




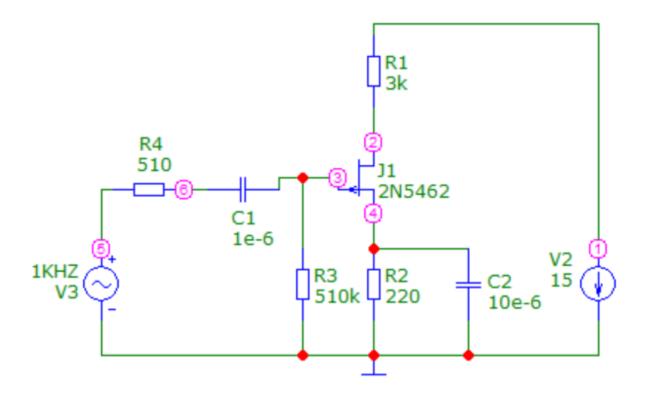
Напряжение отпирания ~3.27В

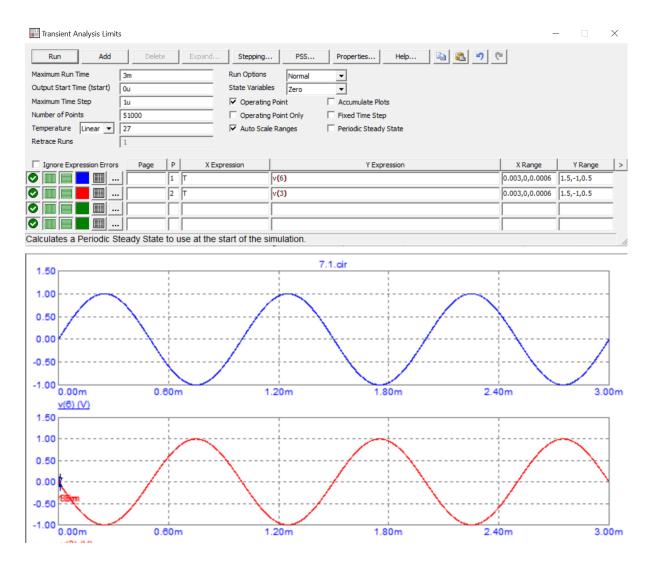
Нормальная выходная характеристика





Соберем усилитель, используя pJFET транзистор

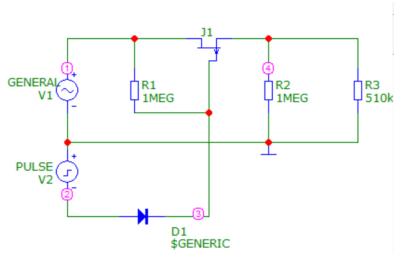


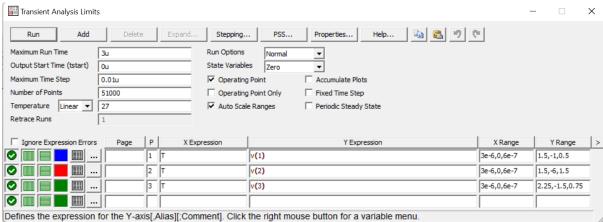


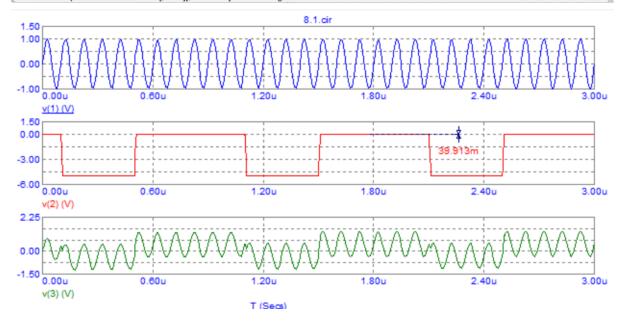
Транзистор почти что не усиливает сигнал, поэтому посчитать коэффициент усиления не получилось

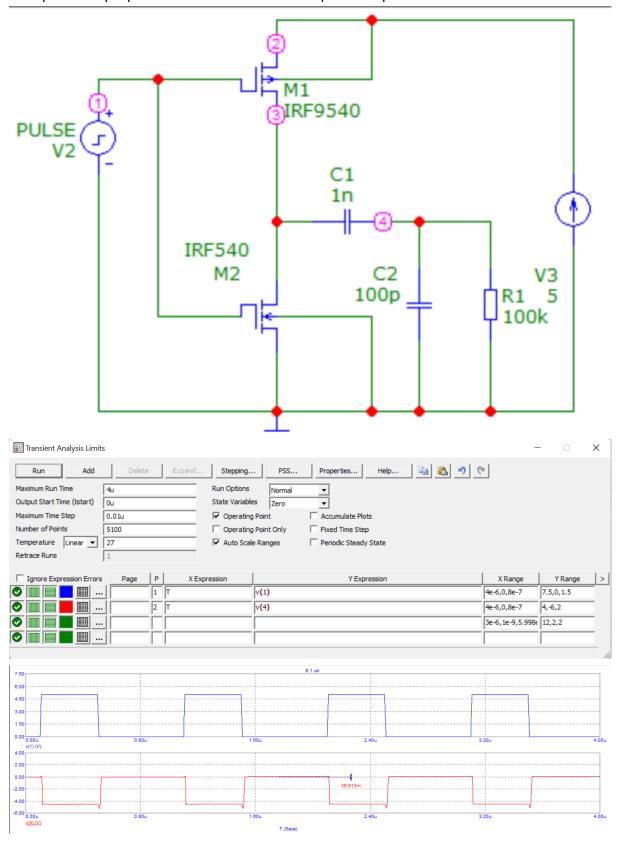
Эксперимент 8

Построим схему ключа с использованием pJFET транзистора









Переходные характеристики:

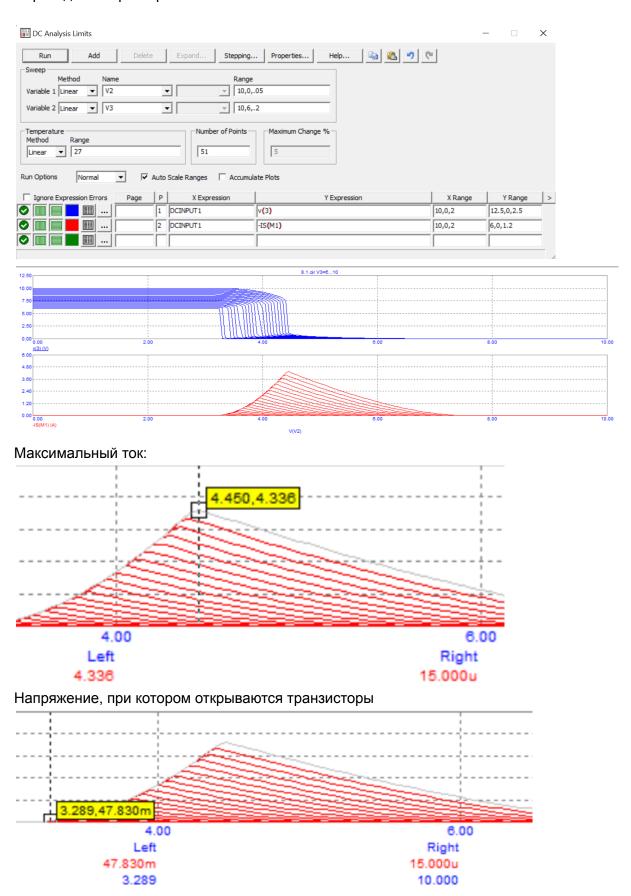
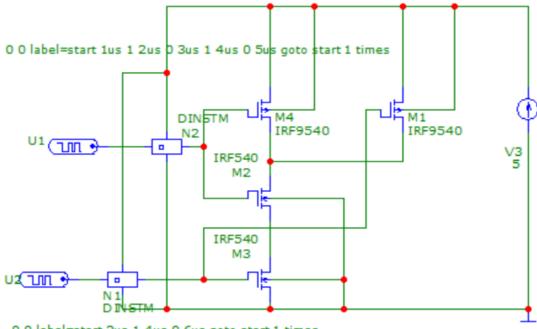


Схема 2И-НЕ



0 0 label=start 2us 1 4us 0 6us goto start 1 times

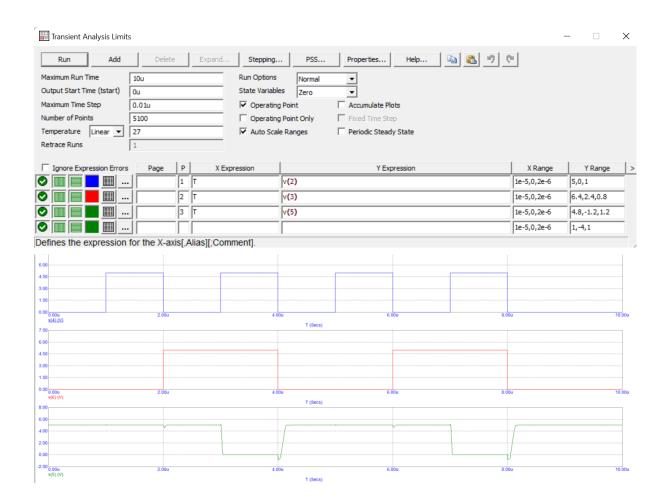


Таблица истинности:

1	2	3
0	0	1
1	0	1
0	1	1
0	0	1

Эксперимент 9

Построим схему триггера памяти с использованием транзисторов

